

14.11.03

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

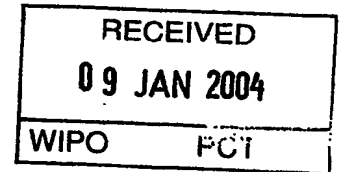
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 0 8 8 1 3
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 0 8 8 1 3]

出 願 人 日 本 板 硝 子 株 式 会 社
Applicant(s):

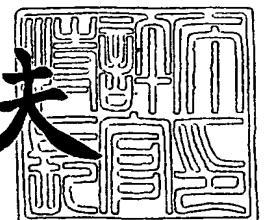


**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 1 2 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 02P427

【提出日】 平成14年10月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C03C 19/00
G11B 5/84

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子
株式会社 内

【氏名】 石井 章聖

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子
株式会社 内

【氏名】 三谷 一石

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子
株式会社 内

【氏名】 斉藤 靖弘

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子
株式会社 内

【氏名】 奥畑 浩治

【特許出願人】

【識別番号】 000004008

【氏名又は名称】 日本板硝子 株式会社

【代理人】

【識別番号】 100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9908293

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気記録媒体用ガラス基板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 中心に円孔を有する円盤状に形成され、表面には同心円を描いて延びる尾根状のテクスチャーが形成された磁気記録媒体用ガラス基板であって、

原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャーの幅 W が $10\sim 200\ \text{nm}$ 、テクスチャーの高さ H が $2\sim 10\ \text{nm}$ であり、テクスチャーの自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p/RMS) が 15 以下であることを特徴とする磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 2】 前記テクスチャーの幅 W が $10\sim 20\ \text{nm}$ である請求項 1 に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 3】 前記テクスチャーの幅 W が $10\sim 20\ \text{nm}$ 、テクスチャーの高さ H が $2\sim 5\ \text{nm}$ 及びテクスチャーの自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p/RMS) が 3 以下である請求項 1 又は請求項 2 に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 4】 原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャーの平均尾根凹部深さ D が $2\ \text{nm}$ 以下で、テクスチャーの平均尾根凹部深さ D に対する高さ H の比 H/D が 10 以上である請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 5】 前記テクスチャーは、原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られる低周波成分と、その上に重畳的に形成され、原子間力顕微鏡で $1\ \mu\text{m}$ 四方又は $0.1\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られ、低周波成分より細かな高周波成分とから構成され、高周波成分のテクスチャーの幅 W' が $0.1\sim 20\ \text{nm}$ で、高周波成分のテクスチャーの高さ H' が $0.1\sim 1\ \text{nm}$ である請求項 1 から請求項 4 のいずれか一項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 6】 前記高周波成分のテクスチャーの幅 W' が $1\sim 5\ \text{nm}$ で、高周波成分のテクスチャーの高さ H' が $0.3\sim 0.8\ \text{nm}$ である請求項 5 に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【請求項 7】 原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャーの最大谷深さ R_v が $10\ \text{nm}$ 以下である請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばコンピュータのハードディスク等として用いられる磁気ディスク、光磁気ディスク等の磁気記録媒体用ガラス基板に関するものである。さらに詳しくは、ガラス基板表面の磁気データを読み取る磁気ヘッドの十分な低浮上化を図るとともに、浮上安定性を向上させることができる磁気記録媒体用ガラス基板に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、この種の磁気記録媒体用ガラス基板としては、次のような構成のものが知られている（例えば、特許文献 1 参照）。

【0003】

すなわち、主表面に同心円状の溝が形成された磁気記録媒体用基板において、同心円状の凹凸の高さが基板上に少なくとも磁性膜を形成させたときに円周方向に異方性を持たない大きさのものである。言い換えれば、円周方向の保磁力を H_{c1} 、半径方向の保磁力を H_{c2} としたときの保磁力の比（ H_{c1}/H_{c2} ）で表される磁気異方性値が $0.90 \sim 1.10$ の範囲に設定されているものである。

【0004】

【特許文献 1】

特開 2002-32909 号公報（第 1 頁及び第 3 頁）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、保磁力の比が $0.90 \sim 1.10$ という磁気異方性の小さいテクスチャーを有するガラス基板においては、ガラス基板上の情報を読み取る磁気ヘッ

ドの浮上安定性を図ることができておらず、低浮上特性としていまだ充分ではないという問題があった。低浮上特性では、限界浮上特性（TDHなど）以外に、連続シークテストや定点浮上テストで評価されるような、磁気ヘッドの耐久性や浮上安定性に係わる特性も重要で、両者を満たしてはじめて良好な低浮上特性が得られる。

【0006】

本発明は、上記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、磁気ヘッドの十分な低浮上化を図るとともに、浮上安定性を向上させることができる磁気記録媒体用ガラス基板を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、中心に円孔を有する円盤状に形成され、表面には同心円を描いて延びる尾根状のテクスチャーが形成された磁気記録媒体用ガラス基板であって、原子間力顕微鏡で $10\mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャーの幅 W が $10\sim 200\text{nm}$ 、テクスチャーの高さ H が $2\sim 10\text{nm}$ であり、テクスチャーの自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比（ R_p/RMS ）が15以下であることを特徴とするものである。

【0008】

請求項2に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項1に記載の発明において、前記テクスチャーの幅 W が $10\sim 20\text{nm}$ であるものである。

請求項3に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項1又は請求項2に記載の発明において、前記テクスチャーの幅 W が $10\sim 20\text{nm}$ 、テクスチャーの高さ H が $2\sim 5\text{nm}$ 及びテクスチャーの自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比（ R_p/RMS ）が3以下であるものである。

【0009】

請求項4に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の発明において、原子間力顕微鏡で $10\mu\text{m}$ 四方の範囲を

測定して得られるテクスチャーの平均尾根凹部深さ D が 2 nm 以下で、テクスチャーの平均尾根凹部深さ D に対する高さ H の比 H/D が 10 以上であるものである。

【0010】

請求項 5 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項 1 から請求項 4 のいずれか一項に記載の発明において、前記テクスチャーは、原子間力顕微鏡で $10\text{ }\mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られる低周波成分と、その上に重畳的に形成され、原子間力顕微鏡で $1\text{ }\mu\text{m}$ 四方又は $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られ、低周波成分より細かな高周波成分とから構成され、高周波成分のテクスチャーの幅 W' が $0.1\sim 20\text{ nm}$ で、高周波成分のテクスチャーの高さ H' が $0.1\sim 1\text{ nm}$ であるものである。

【0011】

請求項 6 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項 5 に記載の発明において、前記高周波成分のテクスチャーの幅 W' が $1\sim 5\text{ nm}$ で、高周波成分のテクスチャーの高さ H' が $0.3\sim 0.8\text{ nm}$ であるものである。

【0012】

請求項 7 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板は、請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載の発明において、原子間力顕微鏡で $10\text{ }\mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャーの最大谷深さ R_v が 10 nm 以下であるものである。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。

図 3 及び図 4 に示すように、本実施形態における磁気記録媒体用ガラス基板 11 (以下、製造工程におけるガラス基板を含めて単にガラス基板とも称する) は中心に円孔 12 を有する円盤状に形成され、磁気ディスク等の磁気記録媒体として使用されるものである。すなわち、ガラス基板 11 の表面には、コバルト (Co)、クロム (Cr)、鉄 (Fe) 等の金属又は合金よりなる磁性膜、保護膜、さらに潤滑膜等を形成することにより磁気記録媒体が構成される。

【0014】

図4に示すように、このガラス基板11上には、同心円を描いて延びる複数のテクスチャー13が形成されている。図1に示すように、テクスチャー13は尾根状（山形状）に形成され、その中心面（基準面）Cより上の部分において、幅がW、高さがHに形成されている。中心面Cは、ガラス基板11表面のガラス基板11と平行な断面で表されるテクスチャー13の面積の総和の50%に相当する等高面（ベアリングレシオ50）を意味する。該テクスチャー13は、原子間力顕微鏡（略称AFM）で10 μ m（ミクロンメートル）四方の範囲を測定して得られるもので、テクスチャー13の幅Wが10～200nm（ナノメートル）、テクスチャー13の高さHが2～10nmのものである。

【0015】

ここで、テクスチャー13の幅Wは、AFMでの測定範囲の長さ／テクスチャーの線密度を表す。テクスチャー13の線密度、すなわちラインデンシティ（Ld）は、テクスチャー13を横切る断面において、テクスチャー13の形状を表す曲線が中心面Cを横切る回数を示す。

【0016】

また、テクスチャー13の高さHは、テクスチャー13を横切る断面において、AFMでの測定範囲内でカウントされるテクスチャー13がn本（ $n = Ld / 2$ ）である場合、個々のテクスチャー13（i）についてテクスチャー13の山頂から谷底までの高さを H_i としたとき、次式で表される。

【0017】

$$H = \sum H_i / n, \text{ 但し、 } i = 1 \sim n, n = Ld / 2$$

さらに、テクスチャー13の自乗平均粗さRMSに対する最大山高さ R_p の比（ R_p / RMS ）が1.5以下のものである。最大山高さ R_p は、前記中心面Cから最も高いテクスチャー13の山頂までの高さをいう。また、自乗平均粗さRMSは、JIS B 0601に規定されているパラメータである。このテクスチャー13は、後述する高周波成分に対して低周波成分であり、テクスチャー13の基本形を形成している。

【0018】

そのようなテクスチャー 13 の幅 W はテクスチャー 13 の密度に関係し、その変化によって磁気記録媒体とされたガラス基板表面に記録された情報（磁気データ）を読み取る読取り装置としての磁気ヘッドの磨耗やスティッキング（固着）が起り、磁気ヘッドのクラッシュに到ることもあるため、重要な要素である。

【0019】

テクスチャー 13 の幅 W が小さくなることは、テクスチャー 13 の密度が高くなることを意味し、テクスチャー 13 の幅 W が 10 nm より小さい場合には磁気ヘッドの磨耗が大きくなり、磁気ヘッドのクラッシュが起り易くなるため不適當である。一方、テクスチャー 13 の幅 W が 200 nm より大きい場合には、磁気ヘッドのスティッキングが起りやすくなり、磁気ヘッドのクラッシュが起って不適當である。このテクスチャー 13 の幅 W は $10\sim 20\text{ nm}$ であることが好ましい。テクスチャー 13 の幅 W がこの範囲であると、磁気ヘッドのスティッキングがより起り難くなり、72 時間にわたる定点浮上テストにおいても磁気ヘッドのクラッシュが起らずより好ましい。

【0020】

次に、テクスチャー 13 の高さ H は、磁気記録媒体とされたガラス基板の最表面に設けられている潤滑膜の保持力及び磁気ヘッドの浮上（グライド）高さに関係し、磁気ヘッドによる読み取り精度と磁気ヘッドのクラッシュに関わることから重要な要素である。テクスチャー 13 の高さ H が 2 nm より小さいと、ガラス基板の最表面に設けられている潤滑膜の保持力が低下し（潤滑膜を保持する溝が少なくなる）、磁気ヘッドのクラッシュが起るようになる。磁気ヘッドの浮上高さはテクスチャー 13 の高さ H とその頂上から磁気ヘッドまでの高さとの和で表されるので、テクスチャー 13 の高さ H が 10 nm より大きいと、中心面 C から上に突き出るテクスチャー 13 の高さは、 10 nm のほぼ半分（ 5 nm ）になり、磁気ヘッドの浮上高さを 5 nm より低くできなくなる。テクスチャー 13 の高さ H が $2\sim 5\text{ nm}$ であれば、上記の効果に加え、磁気記録媒体の記録密度 30 Gbit/in^2 に充分対応できるので好ましい。

【0021】

また、テクスチャー 13 の自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比（

R_p/RMS)は、磁気ヘッドの浮上高さ及び浮上安定性に関係するものであり、重要な要素である。この比(R_p/RMS)が15より大きい場合には、テクスチャー13には相対的に突出した突起が多くなり、磁気ヘッドの磨耗が大きくなり、良好な浮上特性が得られず、例えば2000時間の連続シークテストや24時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュに到る。さらに、この比が5以下であれば、磁気ヘッドの磨耗が小さくなり、例えば2000時間の連続シークテストや72時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起らず、より好ましい。加えて、この比が3以下で、前記テクスチャー13の幅Wが10~20nm、高さHが2~5nmである場合には、例えば96時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起らず、さらに好ましい。

【0022】

次に、テクスチャー13の平均尾根凹部深さDは、図1に示すように、テクスチャー13の円周方向に延びる尾根に形成される凹部14の深さの平均を意味し、この深さDは磁気ヘッドの磨耗と磁気ヘッドのクラッシュに関係することから、2nm以下であることが望ましい。テクスチャー13の尾根は一様な高さで連なるのが理想であるが、実際には尾根上にうねりが形成され、凹部14が存在する。平均尾根凹部深さDが2nmより大きいと磁気ヘッドの磨耗が大きくなり、例えば48時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起こるが、深さDが2nm以下であれば48時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起こることはないのでより好ましい。

【0023】

この平均尾根凹部深さDに関連し、平均尾根凹部深さDに対するテクスチャー13の高さHの比(H/D)はテクスチャー13の上下方向における形状を表し、磁気ヘッドのクラッシュを予測できることから10以上であることが望ましい。この比(H/D)が10より小さいと、テクスチャー13には相対的に崩れた尾根を形成する突起が多くなり、例えば48時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起こるが、比(H/D)が10以上になると48時間にわたる定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起こらないためより好ましい。この比(H/D)の上限は、およそ100である。AFMの測定精度の下限が0

、1 nm程度ということを考慮すると、高さHが10 nm、深さDが0.1 nmのとき、比(H/D)は100となる。

【0024】

次に、テクスチャー13は、前述の低周波成分と、その上に重畳的に形成され、原子間力顕微鏡で1 μ m四方又は0.1 μ m四方の範囲を測定して得られる低周波成分より細かな高周波成分とから構成されていることが認められる。この高周波成分のテクスチャー13aの幅W'は0.1~20 nmで、高周波成分のテクスチャー13aの高さH'は0.1~1 nmであることが好ましい。テクスチャー13aの幅W'及び高さH'をこれらの範囲に設定することにより、磁気記録媒体用ガラス基板11の表面に設けられる磁性膜の結晶の磁気異方性が高まり、前述した保磁力の比(Hc1/Hc2)で表される磁気異方性値が1.1以上になることから好ましい。この場合、テクスチャー13の尾根の斜面における磁気記録密度を高めることができ、特に垂直磁気記録方式の磁気記録媒体に有効である。

【0025】

高周波成分のテクスチャー13aの幅W'が0.1 nm未満又は20 nmを越えると、磁気異方性値が1.1未満に低下し、磁気異方性が十分に発現されず、好ましくない。高周波成分のテクスチャー13aの高さH'が0.1 nm未満又は1 nmを越えると、磁気異方性値が1.1未満に低下し、磁気異方性が十分に発現されず、好ましくない。

【0026】

高周波成分のテクスチャー13aの幅W'が1~5 nmで、高周波成分のテクスチャー13aの高さH'が0.3~0.8 nmであることがより好ましい。この場合には、磁気異方性値が1.2以上となり、磁気異方性を十分に発現させることができる。ガラス基板11がこのような高周波成分のテクスチャー13aを有することにより、ガラス基板11上にスパッタリングによって形成される下地膜や磁性膜の結晶成長に好適な場が得られ、結晶配向が促進されるためと考えられる。

【0027】

また、原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られるテクスチャー 13 の最大谷深さ R_v は、前記中心面 C から最も深い谷の谷底までの深さをいう。最大谷深さ R_v は、局所的な磁気異方性に関係し、 R_v を小さくすることで局所的な磁気異方性の低下を防止することができ、磁気記録媒体用ガラス基板 11 の表面全体として磁気異方性を発現できることから $10\ \text{nm}$ 以下であることが好ましい。この最大谷深さ R_v は、表面粗さを示す粗さ曲線から最も深い谷底までの深さを表す。最大谷深さ R_v が $10\ \text{nm}$ より大きいとその部分で測定した局所的な磁気異方性値が 1.1 より低くなり、十分な磁気異方性を発揮できなくなって好ましくない。さらに、テクスチャー 13 を形成した後のガラス基板表面に磁性膜を設けると、深い溝の部分で結晶配向が乱れて磁気特性が低下し、磁気ヘッドが磁気データの信号を読み取りにくくなるため望ましくない。

【0028】

次に、上記のような磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法について説明する。

図 5 はこの磁気記録媒体用ガラス基板の製造工程を示す工程図である。この図 5 に示すように、磁気ディスクとして用いられる磁気記録媒体用ガラス基板 11 は、円盤加工工程 21、内外周端面面取り工程 22、主表面研磨工程 23、研磨後洗浄工程 24、化学強化工程 25、強化後洗浄工程 26、テクスチャー加工工程 27、洗浄工程 28 及び最終洗浄・乾燥工程 29 を経て製造される。

【0029】

磁気記録媒体用ガラス基板 11 を形成するガラス材料（ガラス素板）としては、二酸化ケイ素（ SiO_2 ）、酸化ナトリウム（ Na_2O ）、酸化カルシウム（ CaO ）を主成分としたソーダライムガラス、 SiO_2 、酸化アルミニウム（ Al_2O_3 ）、 R_2O （ R ＝カリウム（ K ）、ナトリウム（ Na ）、リチウム（ Li ））を主成分としたアルミノシリケートガラス、ボロシリケートガラス、酸化リチウム（ Li_2O ）－ SiO_2 系ガラス、 Li_2O － Al_2O_3 － SiO_2 系ガラス、 $\text{R}'\text{O}$ － Al_2O_3 － SiO_2 系ガラス〔 R' ＝マグネシウム（ Mg ）、カルシウム（ Ca ）、ストロンチウム（ Sr ）又はバリウム（ Ba ）〕等のガラス材料に酸化ジルコニウム（ ZrO_2 ）や酸化チタン（ TiO_2 ）等を添加した化学強化用ガラスであれば特に限定されない。そして、ガラス基板 11 は、例えば外径が $89\ \text{mm}$

m (3.5 インチ)、76 mm (3.0 インチ) 又は 64 mm (2.5 インチ) 等に形成されるとともに、その厚みは 0.63 mm 等に形成される。

【0030】

円盤加工工程 21 においては、フロート法などによって得られたシート状のガラス板を四角形状に切断したガラス基板 11 を超合金又はダイヤモンド製のカッターを用いて円盤状に切断することにより、その中心に図 2 又は図 3 に示す円孔 12 を有する形状に賦形される。

【0031】

次に、内外周端面面取り工程 22 においては、ガラス基板の外径寸法及び内径寸法が所定長さとなるように内外周端面が研削加工されるとともに、研磨スラリーにより内外周端面の角部が研磨されて面取り加工される。具体的には、ガラス基板はダイヤモンド砥粒等の砥粒が付着した砥石によって、その内外周端面が研削加工されるとともに、内外周端面の角部が面取り加工される。

【0032】

主表面研磨工程 23 においては、内外周端面の面取りが施されたガラス基板 11 にラップ研磨加工及び平滑研磨加工を施すことにより、ガラス基板 11 の主表面 15 が研磨加工される。ここで主表面 15 とは、ガラス基板 11 が磁気記録媒体とされたときに情報が記録される表面のことをいう。ラップ研磨加工は、ガラス基板 11 の厚みを所定値にするとともに、反りやうねりを取除いて主表面 15 の平坦性を向上させたり、凹凸やクラック等の大きな欠陥を取除いて表面粗さを細くしたりするために行われる。このラップ研磨加工はガラスの成形時に反りやうねりが許容される範囲であれば、コスト削減などの理由で省略することも可能である。

【0033】

平滑研磨加工は、1 次研磨、2 次研磨等によって磁気記録媒体として使用する場合に要求される平坦性や平滑性を確保するために行われる。用いる研磨材は特に限定されないが、ガラスに対して高い研磨力を有する酸化セリウム系の研磨材が好ましい。研磨材のサイズも特に限定されないが、平滑性と研磨速度を両立させるために、通常 0.1 ~ 3 μ m 程度のものが好ましい。研磨方法も特に限定さ

れないが、人工皮革スエードパッドを上定盤及び下定盤に貼り付けた両面研磨機を用いることにより、低コストで両面を精密に研磨することができる。

【0034】

研磨後洗浄工程は、主表面研磨工程 23 の後に行われ、ガラス基板 11 の主表面 15 に残留する研磨粉を除去するために行われる。具体的には、アルカリ水溶液による洗浄、純水による洗浄及びその後にイソプロピルアルコール (IPA) などによる乾燥が行われる。

【0035】

次に、化学強化工程 25 においては、磁気記録媒体の基板として要求される耐衝撃性、耐振動性、耐熱性等を向上させるために、主表面 15 に研磨加工が施されたガラス基板 11 に化学強化処理が施される。この化学強化処理とは、ガラス基板 11 中に含まれる一部のイオン、例えばリチウムイオンやナトリウムイオン等の一価の金属イオンを、それよりイオン半径が大きいナトリウムイオンやカリウムイオン等の一価の金属イオンにイオン交換することをいう。このようなイオン交換により、ガラス基板 11 の表面に圧縮応力層が形成され、ガラス基板 11 が化学強化される。

【0036】

化学強化処理により形成される圧縮応力層 (化学強化層) の厚みは、ガラス基板 11 表面から好ましくは $100 \sim 200 \mu\text{m}$ である。 $100 \mu\text{m}$ 未満の場合には、ガラス基板 11 の化学強化が不十分となって、磁気記録媒体用の基板として要求される性能を発揮することができないときがある。一方、 $200 \mu\text{m}$ を越える場合には、化学強化処理液の温度を高くしたり、ガラス基板 11 を化学強化処理液に浸漬する時間を長くしたりする必要があるために、ガラス基板 11 の生産効率が低下しやすい。

【0037】

化学強化処理が円滑に行われることにより、ガラス基板 11 全体の強度を確保することができる。ガラス基板 11 は、このようなイオン交換に基づいてその表面に圧縮応力層が形成されて強度が高められることにより、磁気記録媒体として使用されるときに、高速回転による破損を防止することができる。

【0038】

化学強化工程 25 の後には、強化後洗浄工程 26 が行われる。この洗浄工程においては、化学強化されたガラス基板 11 を温水で洗浄することにより、ガラス基板 11 表面に残存する化学強化塩などの異物が洗浄除去される。その結果、後述するテクスチャー加工において、異物によるガラス基板 11 の主表面 15 の傷の発生を防止することができる。

【0039】

前記強化後洗浄工程 26 の後には、テクスチャー加工工程 27 が行われ、図 4 に示すように、ガラス基板 11 の主表面 15 に円周方向に延びるテクスチャー（円周テクスチャー）13 が形成される。テクスチャー加工前にガラス基板 11 の主表面 15 の清浄性を良好にするために、酸処理やアルカリ処理などを施してもよい。テクスチャー加工に供されるガラス基板 11 の主表面 15 の算術平均粗さ R_a は 0.1 ~ 1.5 nm が好ましく、0.1 ~ 1.0 nm がさらに好ましく、0.1 ~ 0.6 nm が特に好ましい。算術平均粗さ R_a は、JIS B 0601 に規定されているパラメータである。この算術平均粗さ R_a が 0.1 nm 未満又は 1.5 nm を越えると、磁気記録媒体用として好適とされる微細なテクスチャー 13 が形成されにくくなる。

【0040】

テクスチャー加工は、ガラス基板 11 の主表面 15 にダイヤモンドスラリーを滴下しながらテープ部材をガラス基板 11 の主表面 15 に摺接することにより行われる。テクスチャー加工を行う装置は特に限定されず、いわゆるテクスチャーマシンが使用される。その構造の概略を図 3 に従って説明する。円盤状をなすガラス基板 11 の直上位置には、ガラス基板 11 の半径方向に延びるローラ 16 が回動自在に支持されている。このローラ 16 の長さはガラス基板 11 の半径にほぼ等しくなるように設定されている。

【0041】

テクスチャー形成用のテープ部材 17 は、図 3 の矢印に示すようにローラ 16 の一側方からガラス基板 11 とローラ 16 の間を通り、ローラ 16 の他側方へ抜けるように構成されている。このテープ部材 17 はガラス基板 11 とローラ 16

の間を通るときにローラ 16 の圧力によりガラス基板 11 の主表面 15 に押圧されて摺接されるようになっている。テープ部材 17 としては、織布、不織布、植毛品などをテープ状に形成したものが用いられる。

【0042】

そして、ガラス基板 11 が図 3 の矢印方向に回転され、その上方から研磨用スラリーとしてのダイヤモンドスラリー 18 が滴下されるとともに、テープ部材 17 が図 3 の矢印方向に移動される。このような動作によってガラス基板 11 の主表面 15 に同心円を描いて延びる尾根状のテクスチャー 13 が形成される。

【0043】

テクスチャー 13 の形成に使用されるテープ部材 17 の材質は特に制限されず、ポリエステルやナイロンなどから構成される繊維の織布、不織布など、この種のテクスチャー 13 を形成するために使用されるものであればいかなるものも用いることができる。

【0044】

また、ダイヤモンドスラリー 18 に含まれるダイヤモンド砥粒の粒子径、形状は特に制限されず、要求されるテクスチャー 13 の線密度等に応じて適宜選定することができる。さらに、研削力を高めるためにダイヤモンドのほかに、酸化セリウムや酸化マンガンなどの砥粒を添加したり、アルカリ剤を添加したりしてもよい。

【0045】

ダイヤモンド砥粒の粒径は、平均粒径 (D_{50}) として $0.05 \sim 0.5 \mu\text{m}$ であることが好ましい。平均粒径が $0.05 \mu\text{m}$ 未満の場合、テクスチャー 13 を形成する能力が低下し、テクスチャー 13 の形成速度が遅くなってテクスチャー加工コストの増大を招いて好ましくない。一方、 $0.5 \mu\text{m}$ を越える場合、ガラス基板 11 の半径方向に小さな尾根を単位長さ当たり多数形成することができず、テクスチャー 13 の線密度を十分に大きくすることができない。

【0046】

ダイヤモンド砥粒を分散させてスラリーとするための溶媒も特に制限されず、またダイヤモンド砥粒の分散性を向上させるために界面活性剤を添加してもよい。

【0047】

テクスチャー 13 の具体的な形成条件は、目的とするテクスチャー 13 の形状、密度、長さに応じて例えば以下のように設定される。

ダイヤモンド砥粒の平均粒径：0.1～0.5 (μm)、ガラス基板 11 の回転速度：200～300 (rpm)、ローラ 16 の押圧力：30～40 (N)、テープ部材 17 の材質：織布又は不織布。

【0048】

次に、テクスチャー加工工程 27 の後に行われる洗浄工程 28 においては、例えばポリウレタン製のスクラブ部材を用い、水にて洗浄することにより行われる。この場合、アルカリ性水溶液を使用したり、超音波を照射したりしてもよい。この洗浄工程 28 においては、テクスチャー加工工程 27 でガラス基板 11 の表面に残留するダイヤモンドスラリー 18 などの異物が除去される。

【0049】

前記洗浄工程 28 の後には、最終洗浄・乾燥工程 29 が行われる。この工程では、アルカリ性水溶液による洗浄、純水による洗浄の後、イソプロピルアルコール (IPA) などの溶剤による乾燥処理が行われる。

【0050】

さて、本実施形態の磁気記録媒体用ガラス基板 11 は、前記の各製造工程を経て製造される。得られたガラス基板 11 表面には、低周波成分のテクスチャー 13 が形成され、そのテクスチャー 13 の幅 W 、高さ H 及びテクスチャー 13 の自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p/RMS) が所定範囲に設定される。すなわち、磁気ヘッドの低浮上化と浮上安定性のために、テクスチャー 13 の形状、密度、異常突起などが適切なものとされる。

【0051】

従って、磁気ヘッドはガラス基板 11 の回転動作時にガラス基板 11 の表面に対して近接した状態で浮上でき、しかも安定して飛行することができる。

以上詳述した本実施形態によれば、次のような効果が発揮される。

【0052】

・ 本実施形態の磁気記録媒体用ガラス基板 11 によれば、低周波成分のテクスチャー 13 の幅 W が $10 \sim 200 \text{ nm}$ 、テクスチャー 13 の高さ H が $2 \sim 10 \text{ nm}$ 、テクスチャー 13 の自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p / RMS) が 15 以下である。このため、テクスチャー 13 の形状及び密度が適切で、異常な突起の形成が抑制され、磁気ヘッドの十分な低浮上化を図ることができるとともに、浮上安定性を向上させることができる。

【0053】

・ また、テクスチャー 13 の幅 W は $10 \sim 20 \text{ nm}$ に設定される。さらに、テクスチャー 13 の平均尾根凹部深さ D が 2 nm 以下で、テクスチャー 13 の平均尾根凹部深さ D に対する高さ H の比 H / D が 10 以上に設定される。このため、磁気ヘッドの低浮上化と浮上安定性をより一層向上させることができる。

【0054】

・ 低周波成分のテクスチャー 13 上には高周波成分のテクスチャー 13 a が重疊的に形成され、高周波成分のテクスチャー 13 a の幅 W' が $0.1 \sim 20 \text{ nm}$ で、高周波成分のテクスチャー 13 a の高さ H' が $0.1 \sim 1 \text{ nm}$ に設定される。このため、低周波成分のテクスチャー 13 の形状に加え、高周波成分のテクスチャー 13 a の形状が適正化され、磁気異方性を向上させることができ、テクスチャー 13 における磁気記録密度を高めることができる。

【0055】

・ また、テクスチャー 13 の最大谷深さ R_v が 10 nm 以下に設定される。このため、テクスチャー 13 の深い谷部での局所的な磁気異方性の低下を防止することができる。

【0056】

【実施例】

以下、前記実施形態を具体化した実施例について説明する。

(実施例 1)

フロート法によりアルミノシリケートガラス (SiO_2 63 モル%、 Al_2O_3 16 モル%、 Na_2O 11 モル%、 Li_2O 4 モル%、 MgO 2 モル%、 CaO 4 モル%) よりなるガラス基板 11 を得た。このガラス基板 11 を、

円盤加工工程 21 において、ダイヤモンド製の Cutter を用い、厚み 1.0 mm、外径 65 mm、内径 20 mm の円盤状とした。

【0057】

続いて、内外周端面面取り工程 22 において、ガラス基板 11 に内外周端面の面取りを施した。主表面研磨工程 23 では、ガラス基板 11 の主表面 15 にラップ研磨加工及び平滑研磨加工を施した。平滑研磨は、酸化セリウムを含有する研磨剤及びアスカー C 硬度が 70 の研磨パッドを用い、ガラス基板 11 の両面を研磨することによって行った。

【0058】

次いで、研磨後洗浄工程 24 において、ポリビニルアルコールを用いたスポンジ洗浄及び強アルカリ性の水溶液を用いた超音波洗浄によってガラス基板 11 表面に付着した研磨粉を除去した後、純水でリンスした。続いて、ガラス基板 11 をイソプロピルアルコール蒸気中で 1 分間乾燥させた。

【0059】

次に、化学強化工程 25 では、350～400℃に加熱した硝酸カリウムと硝酸ナトリウムとの混合熔融塩中にガラス基板 11 を 90 分間浸漬することによって、ガラス基板 11 中のリチウムイオンやナトリウムイオンをそれらよりイオン半径の大きいカリウムイオンに置換する化学強化処理を行った。

【0060】

強化後洗浄工程 26 において、化学強化されたガラス基板 11 を水中に浸漬し、熔融塩を除去した。

次に、テクスチャー加工工程 27 にて、テクスチャーマシンを使用し、ガラス基板 11 を回転させながらダイヤモンドスラリーを滴下し、次のような条件でガラス基板 11 の主表面 15 にテクスチャー加工を行った。

【0061】

ダイヤモンド砥粒の粒子径: 0.2 (μm)、ガラス基板 11 の回転速度: 300 (rpm)、ローラ 16 の押圧力: 30 (N)、テープ部材 17 の材質: 織布、ローラ 16 の硬度 50 (duro)。

【0062】

テクスチャー加工後の洗浄工程 28 においては、水酸化カリウム水溶液 (pH 11) を用い、ポリウレタン製のスクラブ部材で $1 \times 10^{-3} \text{Pa}$ の圧力にてアルカリ水溶液洗浄を行った。その後、最終洗浄・乾燥工程 29 において、純水洗浄及びイソプロピルアルコール (IPA) による乾燥を行なった。以上の製造条件を表 1 にまとめて示した。

【0063】

【表 1】

	強化後洗浄工程	テクスチャー加工工程				洗浄工程	
		ダイヤスラリーの粒径 (μm)	回転数 (rpm)	押付荷重 (N)	研磨テープの種類	時間 (秒)	pH
実施例 1	なし	0.1	200	30	織布	10	11
実施例 2	なし	0.2	300	40	織布	15	11
実施例 3	なし	0.2	300	30	織布	10	11
実施例 4	0.1wt%硫酸処理	0.2	300	30	織布	5	11
実施例 5	なし	0.3	300	30	織布	10	11
実施例 6	なし	0.5	200	30	織布	5	12
比較例 1	なし	0.5	200	40	不織布	5	11
比較例 2	なし	0.5	300	30	織布	5	11
比較例 3	なし	0.1	300	30	織布	10	11
比較例 4	なし	0.1	300	30	不織布	10	11
比較例 5	なし	0.1	300	40	不織布	5	11
比較例 6	なし	0.5	200	30	織布	なし	11
実施例 7	なし	0.1	200	30	織布	10	11
実施例 8	なし	0.3	300	30	不織布	10	11
実施例 9	2ppmHF処理	0.5	200	30	織布	5	12
実施例 10	0.1wt%硫酸処理	0.5	200	30	織布	5	12
実施例 11	なし	0.1	200	30	織布	10	10
実施例 12	なし	0.2	300	40	織布	15	9.5
実施例 13	なし	0.3	300	30	不織布	10	9.5
実施例 14	なし	0.3	300	30	不織布	10	10.5
実施例 15	なし	0.5	200	30	織布	5	10
実施例 16	なし	0.5	200	30	織布	5	11.5
実施例 17	0.5wt%硫酸処理	0.2	300	40	織布	15	9.5
実施例 18	0.05wt%硫酸処理	0.1	200	30	織布	10	10
実施例 19	0.1wt%硫酸処理	0.5	200	30	織布	5	10
実施例 20	なし	0.3	300	30	不織布	10	11
実施例 21	なし	0.3	300	50	不織布	10	11
実施例 22	なし	0.5	200	30	織布	5	11
実施例 23	なし	0.5	200	50	織布	5	11

得られた磁気記録媒体用ガラス基板 11 は、デジタルインストルメント社製の

A FMを使用し、 $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定したところ、テクスチャー13の幅Wが $10\ \text{nm}$ 、高さHが $2\ \text{nm}$ 及びテクスチャー13の最大山高さ R_p と自乗平均粗さRMSとの比(R_p/RMS)は1.5であった。このガラス基板11について、動作テスト(ドライブテスト)として連続シークテスト及び定点浮上テストを次のようにして行った。それらの結果を表2に示した。

【0064】

連続シークテスト: 2000時間のドライブテストにおける磁気ヘッドのクラッシュの有無を測定した。

定点浮上テスト: 減圧下($26.7\ \text{kPa}$)に、磁気ヘッド上方の定点にて磁気ヘッドの浮上テスト(24時間後、48時間後、72時間後、96時間後)におけるヘッドクラッシュの有無を測定した。

(比較例1~6)

ガラス基板11の製造条件を変更し、テクスチャー13の幅W、高さH及びテクスチャー13の最大山高さ R_p と自乗平均粗さRMSとの比(R_p/RMS)を表2に示すように変える以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体用ガラス基板を得た。そのガラス基板について実施例1と同様に連続シークテスト及び定点浮上テストを行った。その結果を表2に示した。

(実施例2~6)

ガラス基板11の製造条件を変更し、テクスチャー13の幅W、高さH及びテクスチャー13の最大山高さ R_p と自乗平均粗さRMSとの比(R_p/RMS)を表2に示すように変える以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体用ガラス基板11を得た。そのガラス基板11について実施例1と同様に連続シークテスト及び定点浮上テストを行った。その結果を表2に示した。

【0065】

【表 2】

	W (nm)	H (nm)	Rp/RMS	ドライブテスト				
				連続シーク	定点浮上			
					2000hr	24hr	48hr	72hr
実施例1	10	2	1.5	無し	無し	無し	無し	無し
実施例2	16	3	2	無し	無し	無し	無し	無し
実施例3	20	5	3	無し	無し	無し	無し	無し
実施例4	20	6	4	無し	無し	無し	無し	有り
実施例5	50	5	8	無し	無し	無し	有り	
実施例6	200	10	15	無し	無し	無し	有り	
比較例1	250	8	9	有り	有り			
比較例2	300	8	8	有り	有り			
比較例3	7	3	3	有り	有り			
比較例4	6	1.5	2	有り	有り			
比較例5	160	1.5	11	有り	有り			
比較例6	200	10	18	有り	有り			

表 2 に示したように、実施例 1 ～ 3 については、テクスチャー 13 の幅 W が 10 ～ 20 nm、テクスチャー 13 の高さ H が 2 ～ 5 nm 及び比 (Rp/RMS) が 3 以下であることから、連続シークテスト及び 96 時間に及ぶ定点浮上テストにおいて磁気ヘッドのクラッシュは起らなかった。また、実施例 4 については、テクスチャー 13 の幅 W が 10 ～ 20 nm、テクスチャー 13 の高さ H が 2 ～ 10 nm 及び比 (Rp/RMS) が 5 以下であることから、連続シークテスト及び 72 時間に及ぶ定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュは起らなかった。さらに、実施例 5 及び 6 については、テクスチャー 13 の幅 W が 20 nm を越えていることから、定点浮上テストにおいて実施例 1 ～ 3 には劣るものの 48 時間までは磁気ヘッドのクラッシュは起らなかった。

【0066】

これに対し、比較例 1 及び 2 ではテクスチャーの幅 W が 200 nm を越えていることから、連続シークテスト及び 24 時間の定点浮上テストにおいて磁気ヘッドのクラッシュが発生した。比較例 3 ではテクスチャーの幅 W が 10 nm を下回っていることから、連続シークテスト及び 24 時間の定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起きた。比較例 4 及び 5 ではテクスチャーの高さ H が 2 nm 未

満又は10 nmを越えているため、連続シークテスト及び24時間の定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起きた。比較例6においては、比(R_p/R_{MS})が15を越えているため、連続シークテスト及び24時間の定点浮上テストで磁気ヘッドのクラッシュが起きた。

(実施例7～10)

ガラス基板11の製造条件を変更し、テクスチャー13の平均尾根凹部深さD及びテクスチャー13の平均尾根凹部深さDに対する高さHの比 H/D を表3に示すように設定する以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体用ガラス基板11を得た。得られたガラス基板11について実施例1と同様に連続シークテスト及び定点浮上テストを行った。その結果を表3に示した。

【0067】

【表3】

	D (nm)	H/D	ドライブテスト			
			連続シーク	定点浮上		
			2000hr	24hr	48hr	72hr
実施例7	0.1	15	無し	無し	無し	無し
実施例8	2	20	無し	無し	無し	無し
実施例9	2.5	16	無し	無し	有り	
実施例10	1.5	9	無し	無し	有り	

表3に示したように、実施例7及び8では平均尾根凹部深さDが2 nm以下で、 H/D が10以上であることから、連続シークテスト及び72時間に及ぶ定点浮上テストにおいて磁気ヘッドのクラッシュは発生しなかった。実施例9ではDが2 nmを越え、実施例10では H/D が10未満であるため、実施例7及び8に比べて定点浮上テストで劣るものの24時間までは磁気ヘッドのクラッシュは起らなかった。

(実施例11～19)

ガラス基板11の製造条件を変更し、高周波成分のテクスチャーの幅 W' 及び高さ H' を表4に示すように設定する以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体用ガラス基板11を得た。そのガラス基板11について磁気異方性値を測定した。その結果を表4に示した。

【0068】

【表4】

	W' (nm)	H' (nm)	OR	ドライブテスト	
				連続シーク	定点浮上
				2000hr	24hr
実施例11	0.1	0.1	1.19	無し	無し
実施例12	1	0.3	1.28	無し	無し
実施例13	5	0.8	1.25	無し	無し
実施例14	14	1	1.18	無し	無し
実施例15	20	1	1.15	無し	無し
実施例16	23	0.9	1.09	無し	無し
実施例17	0.05	0.1	1.07	無し	無し
実施例18	0.1	0.05	1.03	無し	無し
実施例19	18	1.2	1.05	無し	無し

表4に示したように、実施例11～15においては、高周波成分のテクスチャーの幅W'が0.1～20nm、高周波成分のテクスチャーの高さH'が0.1～1nmの範囲内であることから、磁気異方性は1.15以上で十分な磁気異方性を有している。実施例16及び17は高周波成分のテクスチャーの幅W'が20nmを越えるか又は0.1nm未満であるため、磁気異方性値が1.07～1.09であり、磁気異方性が低下した。実施例18及び19は高周波成分のテクスチャーの高さH'が0.1未満又は1nmを越えるため、磁気異方性値が1.03～1.05であり、磁気異方性が低下した。

(実施例20～23)

ガラス基板11の製造条件を変更し、テクスチャーの最大谷深さRvを表5に示すように設定する以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体用ガラス基板11を得た。得られたガラス基板11について磁気異方性値を測定した。その結果を表4に示した。

【0069】

【表 5】

	Rv (nm)	OR'	ドライブテスト	
			連続シーク	定点浮上
			2000hr	24hr
実施例20	2	1.23	無し	無し
実施例21	5	1.21	無し	無し
実施例22	10	1.08	無し	無し
実施例23	15	1.05	無し	無し

表5に示したように、実施例20及び21においては、最大谷深さRvが5nm以下であることから、磁気異方性値が1.21～1.23を示し、磁気異方性が高いのに比べ、実施例22及び23では最大谷深さRvが10～15nmであるため磁気異方性値が1.05～1.08まで下がり、磁気異方性が低下した。
(応用例1～4)

前記比較例1、比較例5、実施例2及び比較例4のサンプルを用い、雰囲気圧力を表6に示す常圧及び減圧下に磁気ヘッドが受けるガラス基板の接線方向の力を測定した。その測定方法について説明すると、図6に示すように、3000rpmで回転するガラス基板11の定点上方位置には、支持装置本体31から延びる支持金具32に支持された磁気ヘッド33が配置されている。支持金具32の基端部には歪ゲージセンサ34が設けられ、その歪ゲージセンサ34により磁気ヘッド33が受ける接線方向の力を測定し、電圧値(mV)で表した。その結果を表6及び図7に示した。

【0070】

【表 6】

	サンプル	雰囲気圧力(kPa)						W (nm)	H (nm)
		101.5	80.1	66.8	53.4	40.1	26.7		
応用例1	比較例1	-33.0	-32.0	-33.4	-40.1	-72.0	-19.7	250	8
応用例2	比較例5	-28.0	-29.7	-64.6	-109.2	-16.8	-14.1	160	1.5
応用例3	実施例2	-35.5	-34.0	-37.2	-36.5	-34.8	-31.4	16	3
応用例4	比較例4	-32.1	-33.0	-39.9	-62.6	-99.8	-22.5	6	1.5

表6及び図7に示したように、サンプルが実施例2の場合(応用例3)には雰

囲気圧力が下がっても磁気ヘッド 33 が受ける接線方向の力はほとんど変化しなかった。それに対し、サンプルが比較例 1、比較例 5 及び比較例 4 の場合には雰囲気圧力が 40.1 ~ 80.1 (kPa) に低下すると、磁気ヘッド 33 が受ける接線方向の力は増大し、磁気ヘッド 33 がガラス基板 11 表面のテクスチャー 13 と接触することが明らかになった。

【0071】

なお、前記実施形態又は実施例を次のように変更して構成してもよい。

- ・ 高周波成分のテクスチャー 13 の幅 W' が 0.1 ~ 20 nm 及び高周波成分のテクスチャー 13 a の高さ H' が 0.1 ~ 1 nm のいずれか一方が満たされるテクスチャーであってもよい。また、高周波成分のテクスチャー 13 a は認められなくてもよい。

【0072】

- ・ テクスチャー 13 の平均尾根凹部深さ D が 2 nm を越えたり、テクスチャー 13 の平均尾根凹部深さ D に対する高さ H の比 H/D が 1.0 未満であってもよい。

【0073】

次に、前記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。

- ・ 半径方向の保磁力 H_{c2} に対する円周方向の保磁力 H_{c1} の比 (H_{c1}/H_{c2}) が 1.1 を越え 1.3 以下である請求項 1 から請求項 7 のいずれか一項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。このように構成した場合、磁気異方性を高めて磁気記録密度を向上させることができる。

【0074】

- ・ 前記テクスチャーの自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p/RMS) は、5 以下である請求項 1 又は請求項 2 に記載の磁気記録媒体用ガラス基板。このように構成した場合、磁気ヘッドの低浮上化と浮上安定性をさらに向上させることができる。

【0075】

【発明の効果】

本発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。

請求項 1 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板によれば、磁気ヘッドの充分な低浮上化を図るとともに、浮上安定性を向上させることができる。

【0076】

請求項 2 から請求項 4 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板によれば、請求項 1 に記載の発明の効果をさらに向上させることができる。

請求項 5 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板によれば、請求項 1 から請求項 4 のいずれか一項に記載の発明の効果に加え、磁気異方性を向上させて、テクスチャーにおける磁気記録密度を高めることができる。

【0077】

請求項 6 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板によれば、請求項 5 に記載の発明の効果をさらに向上させることができる。

請求項 7 に記載の発明の磁気記録媒体用ガラス基板によれば、請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載の発明の効果に加え、局所的な磁気異方性の低下を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

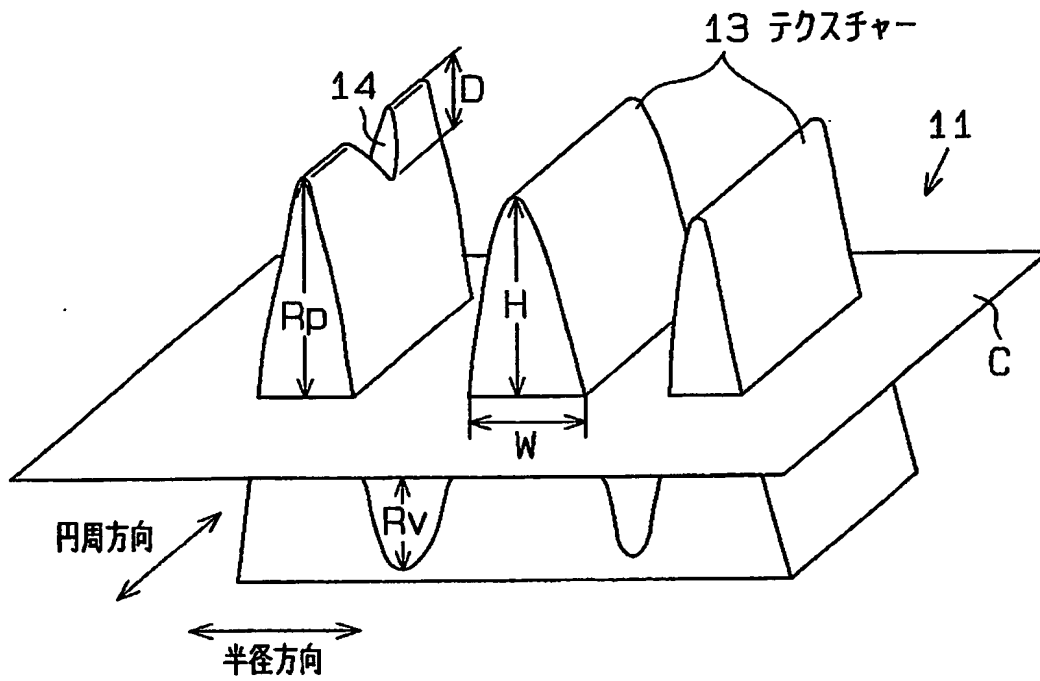
- 【図 1】 実施形態における低周波成分のテクスチャーを示す概念図。
- 【図 2】 実施形態における高周波成分のテクスチャーを示す概念図。
- 【図 3】 ガラス基板の主表面にテクスチャーを形成する装置の斜視図。
- 【図 4】 テクスチャー形成後のガラス基板の主表面を示す平面図。
- 【図 5】 磁気記録媒体用ガラス基板の製造工程を示す工程図。
- 【図 6】 定点浮上テストのための装置を示す概略平面図。
- 【図 7】 雰囲気圧力と磁気ヘッドが受ける接線力との関係を示すグラフ。

【符号の説明】

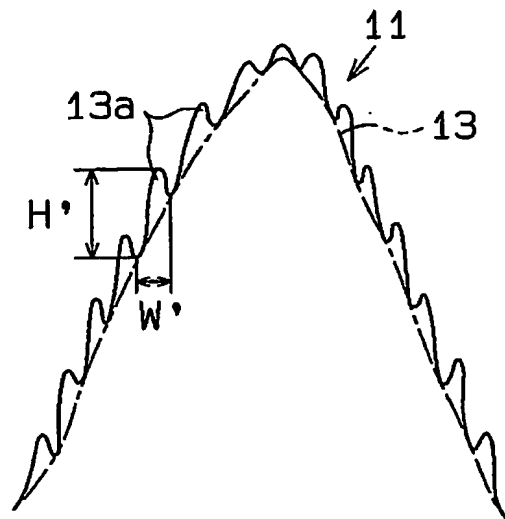
11…磁気記録媒体用ガラス基板、12…円孔、13…テクスチャー、13a…高周波成分のテクスチャー、H…テクスチャーの高さ、W…テクスチャーの幅、D…平均尾根凹部深さ、R_p…最大山高さ、R_v…最大谷深さ。

【書類名】 図面

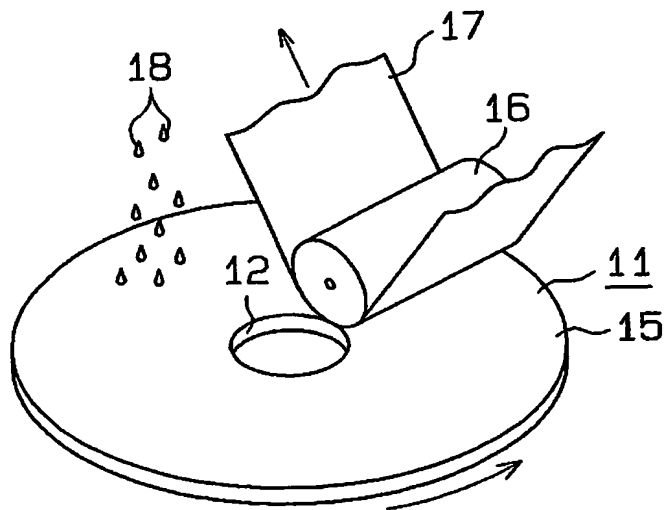
【図 1】



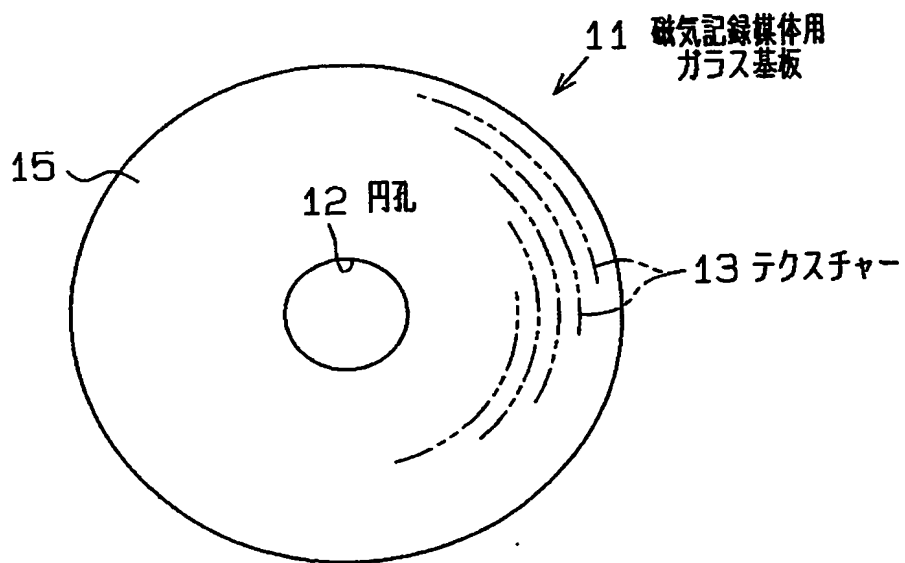
【図 2】



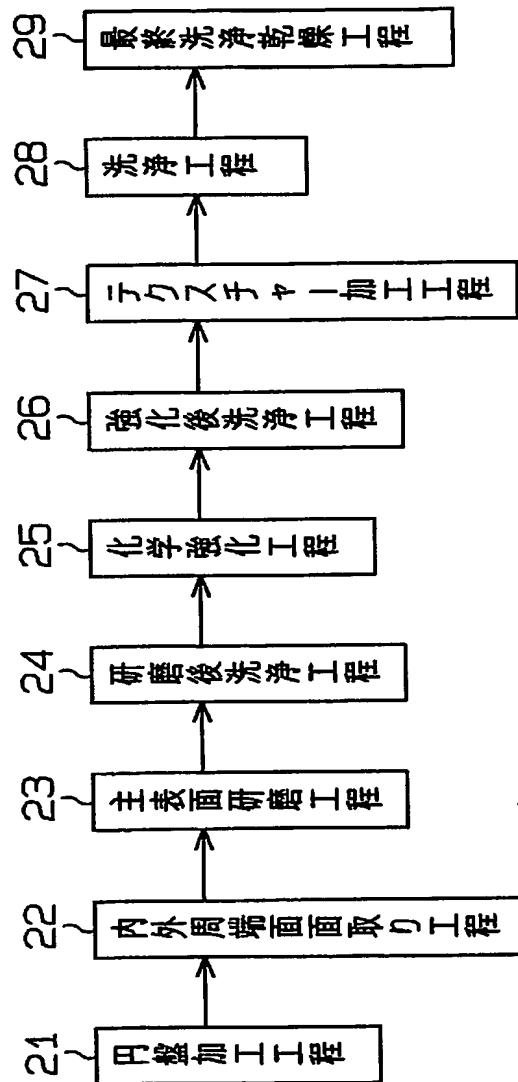
【図 3】



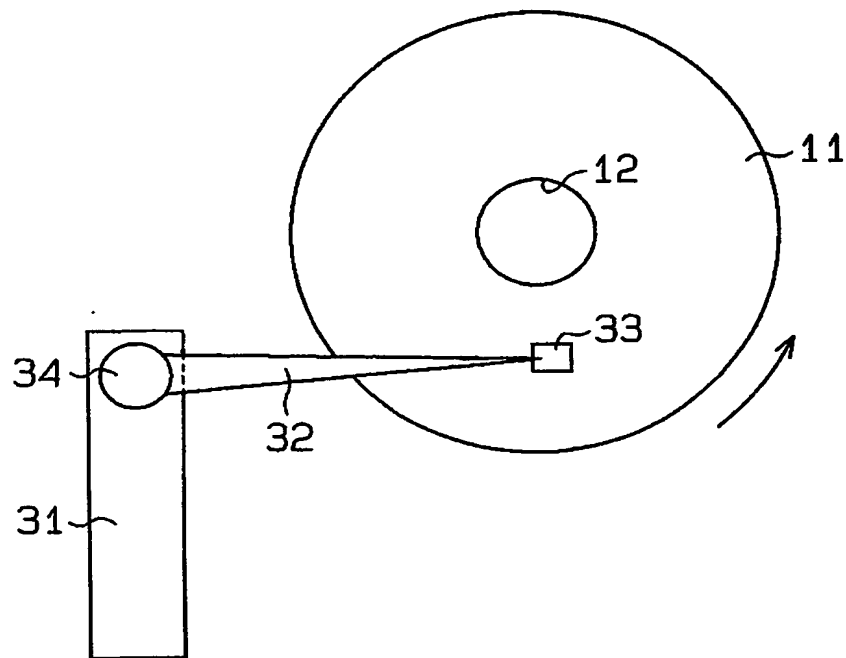
【図 4】



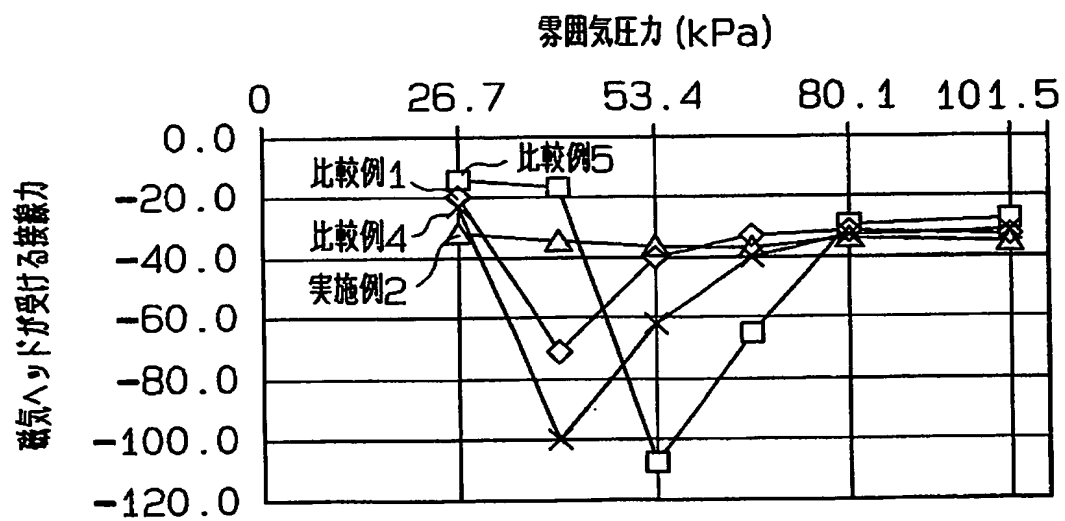
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気ヘッドの十分な低浮上化を図るとともに、浮上安定性を向上させることができる磁気記録媒体用ガラス基板を提供する。

【解決手段】 磁気記録媒体用ガラス基板は、中心に円孔を有する円盤状に形成され、表面には同心円を描いて延びる尾根状のテクスチャー 13 が形成されている。原子間力顕微鏡で $10\ \mu\text{m}$ 四方の範囲を測定して得られる低周波成分のテクスチャー 13 の幅 W は $10\sim 200\ \text{nm}$ 、テクスチャー 13 の高さ H は $2\sim 10\ \text{nm}$ 、テクスチャー 13 の自乗平均粗さ RMS に対する最大山高さ R_p の比 (R_p/RMS) は 15 以下である。低周波成分には高周波成分が重畳的に形成され、その高周波成分のテクスチャーの幅 W' は $0.1\sim 20\ \text{nm}$ で、高さ H' は $0.1\sim 1\ \text{nm}$ であることが好ましい。

【選択図】 図 1

特願 2002-308813

出願人履歴情報

識別番号

[000004008]

1. 変更年月日

2000年12月14日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号

氏 名

日本板硝子株式会社